

NUBIC 知的財産情報開示

開示日：2022年7月15日

各 位

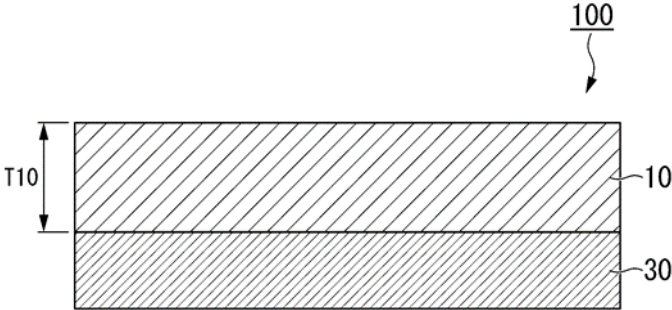
NUBIC 知的財産情報の要約を公開いたします。

技術移転等を御希望の場合は、ホームページの「**NUBIC 技術シーズ案件申込**」フォームからお申込みください。各担当コーディネーターから御連絡申し上げます。

「NUBIC 技術シーズ案件申込」フォーム：

TOP>共同・受託研究>申込書／契約書>本学研究シーズの利活用の申込み>WEB から

出願番号 整理番号 担当者

表題	半導体材料、光電変換素子、LED素子、及び半導体材料の製造方法		
発明の概要・応用	<p>【課題】 組成元素の一部が欠損するのを抑制し、結晶性の高いペロブスカイト酸化物で構成された半導体材料、該半導体材料で構成された半導体層を備える積層構造体、光電変換素子又はLED素子、及び積層構造体の製造方法を提供する。</p> <p>【解決手段】 この半導体材料は、一般式ABX_3（式中、AはCs又はCH_3NH_3であり、BはPb又はSnであり、XはBr、I及びClからなる群から選択されるいずれかの元素である）…（1）で示されるハライド化金属ペロブスカイトで構成されている。</p>		
発明の特徴・効果	<p>本発明によれば、組成元素の一部が欠損するのを抑制し、結晶性の高いペロブスカイト酸化物で構成された半導体材料、該半導体材料で構成された半導体層を備えるLED素子及び光電変換素子、並びに上記半導体材料の製造方法を提供することができる。</p> 		
技術分野	電気・電子		